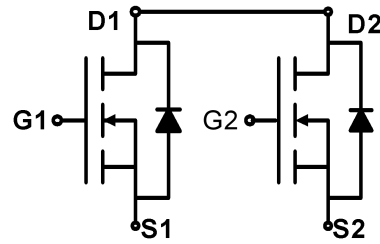




描述

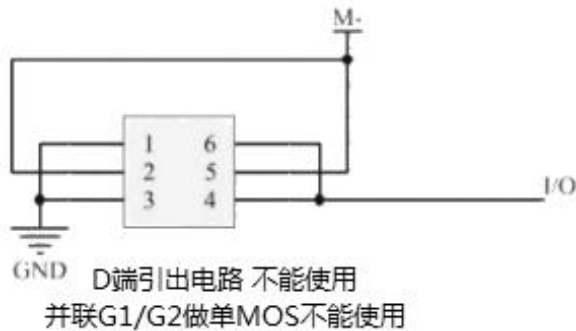
- 20V MOSFET 技术
- 极低的导通电阻
- 超快的开关速度
- Drain(2、5 脚内部连接金属线连接)。
- $V_{GS} \pm 8V$



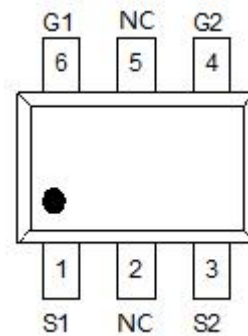
电路结构图

应用

- 用于单节锂电池保护（仅限于锂电池保护板使用）
- 不适用电路如（图一），不可当 10mohm MOSFET 并联使用！
- 封装形式: **SOT23-6**



（图一）



8205C/SOT23-6

（(D1/D2 Pin2 和 Pin5 不连出)）

订购信息

工作温度范围（结温）	封装		型号	包装数量
-55° C ~ +150° C	SOT23-6	Pb-Free	8205C	3000 片/盘

备注：（2、5 脚内部金属线连接）。



深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

8205C (文件编号: S&CIC1660)

20V N 沟道增强型 MOS 场效应管

最大额定值

参数	符号	值	单位
漏源电压	VBDSB	20	V
栅源电压	VBGSB	±8	V
漏极电流, VBGS B=4.5V, @TBaB=25° C	IBD B	6	A
漏极电流, VBGS B=4.5V, @TBaB=70° C	IBD B	4.0	A
漏极脉冲电流 (注 1)	IBDMB	20	A
工作结温	TBjB	-55 ~ +150	° C
存储温度	TBstgB	-55 ~ +150	° C

电气特性(Ta = 25°C, 除非另有说明。)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BVBDSSB	VBGS B= 0, IBD B= 250μA	19.5	20.5		V
漏源漏电流	IBDSSB	VBDSB = 16V, VBGS B= 0	-	-	1	μA
栅源漏电流	IBGSSB	VBGSB = ±6V, VBDSB = 0	-	-	±1	uA
击穿电压温度系数	ΔBVBDSS / ΔTBjB	参考点 25° C IBDB = 1mA	-	0.03	-	V/° C
栅极门限电压	VBGS(th)B	VBDSB = VBGSB, IBD B= 250μA	0.4	0.65	1.0	V
漏源导通电阻	RBSS(ON)B	VBGSB = 4.5V, IBD B= 6A	-	54	68	m Ω
		VGS=3.8V, IBD B= 3A		60	72	m Ω
		VBGSB = 2.5V, IBD B= 3.0A	-	64	78	m Ω
正向跨导	gBfsB	VBDSB = 5V, IBD B= 4.5A	-	10	-	S
源漏正向导通电压	VBSD B	IBSB=1.0A, VBGSB=0V TBjB=25° C	-	0.72	1.2	V



封装信息

➤ SOT23-6

